

Тематический указатель статей, опубликованных в 1999 году

Фундаментальные исследования

Авдеев А.Ю., Гончаров В.А. Решение задачи Стефана для нестационарного процесса роста кристаллов в условиях микрогравитации. № 1-2 стр. 9.

Гаврилов С.А., Коркишко Ю.Н., Федоров В.А., Караванский В.А. Двухлучепреломление в планарных волноводах на основе термически окисленного пористого кремния. № 1-2 стр. 3.

Малышев В.А. Метод анализа микроволновых нелинейных процессов в объеме полупроводников с переменной эффективной массой носителей заряда, в сверхрешетках и в приборах на их основе. № 4 стр. 3.

Неволин В.К. Квантовый одночастичный транспорт. № 5 стр. 3.

Чучмай И.А., Хохлов А.Ф., Машин А.И., Ершов А.В., Андреев С.С. Особенности электропереноса в многослойных наноструктурах $a\text{-Si/ZrO}_x$. № 5 стр. 15.

Материалы электронной техники

Громов Д.Г. Физико-химические процессы формирования многослойной структуры при твердофазном взаимодействии тонких пленок сплавов переходных металлов с кремнием. № 1-2 стр. 17.

Гусейнов Я.Ю. Эффекты отрицательного сопротивления и переключения в пленках аморфного гидрогенизированного кремния. № 6 стр. 13.

Ермолаева А.И., Кошелев Н.И., Дворников С.А. Исследование стекловидных материалов фосфороборосиликатной системы, синтезированных методом золь-гель. № 1-2 стр. 31.

Костишко Б.М., Атажанов Ш.Р., Миков С.Н., Нагорнов С.Ю. Электронно-стимулированная модификация состава карбонизированного пористого кремния. № 6 стр. 5.

Лучинин В.В., Лютецкая И.Г., Сазанов А.П. Реактивное ионно-плазменное травление композиции карбид кремния - нитрид алюминия. № 3 стр. 3.

Рембеза С.И., Свистова Т.В., Подкопаева О.И., Рембеза Е.С. Исследование свойств пленок диоксида олова, полученных методом магнетронного распыления. № 1-2 стр. 26.

Шишкарев В.В., Булярский С.В., Соколовский В.Р. Сегнетоэлектрический композиционный материал для конденсаторных толстых пленок. № 5 стр. 21.

Вакуумная электроника

Анащенко А.В., Кудрявцев А.Н., Шешин Е.П. Эмиссионные свойства и структура углеродных волокон. № 1-2 стр. 37.

Микроэлектроника и полупроводниковые приборы

Абрамов А.А. Малосигнальные характеристики узкобазовых $p\text{-}i\text{-}n$ -диодов с неидеально инжектирующими переходами. № 5 стр. 49.

Алгазинов Э.К., Бобрешов А.М., Дыбой А.В. Физико-топологическая модель GaAs полевого транзистора с затвором Шотки с учетом паразитных сопротивлений. № 3 стр. 31.

Алгазинов Э.К., Бобрешов А.М., Иркутский О.А. Определение параметров модели на примере полевого транзистора. № 6 стр. 35.

Алексеев Ю.И., Ежов С.В. Анализ импедансных свойств диодов Ганна при двухсигнальном воздействии. № 1-2 стр. 58.

Балашова Г.И., Галушков А.И., Сауров А.Н. Применение методов самоформирования для создания транзисторных структур УБИС с субмикронными размерами. № 5 стр. 60.

Бормонтов Е.Н., Борисов С.Н., Волков О.В., Левин М.Н., Лукин С.В. Моделирование вольт-фарадных характеристик для контроля электрофизических параметров МДП-структур со сложным профилем легирования. № 5 стр. 33.

Булярский С.В., Серезжин Ю.Н., Ионычев В.К. Определение параметров глубоких энергетических уровней в кремнии на основе анализа рекомбинационного тока $p-n$ -перехода. № 1-2 стр. 41.

Васин С.В., Тулвинский В.Б., Шипатов Э.Т. Аномальная деградация структур Al - SiO₂ - Si в электрических полях. № 4 стр. 11.

Гаврушко В.В., Сапожников А.А., Косогов О.В., Раскин А.А. Статические характеристики биполярных транзисторов на основе антимонида индия. № 5 стр. 57.

Гайдуков Г.Н., Жаринова Н.Н., Кожевников Е.А. Компьютерный анализ эпитаксиального роста наноразмерных структур. № 3 стр. 15.

Горбатый И.Н. Переходной процесс включения S -диода с омической утечкой в инжектирующем переходе. № 1-2 стр. 52.

Горлов М.И., Андреев А.В. Использование встроенных тестовых структур для анализа отказов ИС. № 4 стр. 28.

Горлов М.И., Бордюжа О.Л. Разделение биполярных ИС по уровням потенциальной надежности. № 1-2 стр. 71.

Горлов М.И., Строгонов А.В. Прогнозирование долговечности кремниевых биполярных логических ИС по параметрическим отказам. № 3 стр. 52.

Горлов М.И., Строгонов А.В., Мартынов В.В., Башкатов М.В. Влияние длительных механических воздействий на дрейф электрических параметров ИС серии 134. № 6 стр. 55.

Громов Д.Г., Мочалов А.И., Пугачевич В.П., Сулимин А.Д., Евдокимов В.Л., Волк Ч.П., Трайнис Т.П. Самосовмещенное формирование контактного слоя CoSi и диффузионно-барьерного слоя TiN. № 3 стр. 20.

Дикарев Ю.И., Цветков С.М., Суровцев И.С. Влияние технологических загрязнений поверхностей Si и SiO₂ на скорость плазмохимического травления. № 3 стр. 26.

Евстигнеев С.В., Шипицин Д.С. Механизмы резонансного туннелирования электронов в трехбарьерной структуре. № 5 стр. 27.

Зенин В.В., Бокарев Д.И., Сегал Ю.Е. Исследование микросварных соединений алюминиевой проволоки с золотым гальваническим покрытием корпусов изделий электронной техники. № 5 стр. 67.

Касимова Ф.Ф., Джавадов Н.Г. Стимулированное светом отрицательное сопротивление в кремниевых $p-n$ -переходах с поликристаллической базой. № 1-2 стр. 47.

Куршева Е.Н., Петров Б.К. Устойчивость мощных высоковольтных ДМОП-транзисторных структур к явлениям лавинного пробоя. № 6 стр. 30.

Лысенко А.П. Анализ характеристик БИСПИН-прибора в стационарно закрытом состоянии. № 3 стр. 35.

Лысенко А.П. Диаграмма состояний БИСПИН-прибора - нового элемента АЦП для оптоэлектроники. № 4 стр. 16.

Лысенко А.П. Переходные процессы в БИСПИН-приборе при подаче импульса освещенности. № 6 стр. 24.

Мещеряков С.А., Проконьев А.И., Рембеза С.И., Бойко В.И. Границы применимости моделей диода Шотки в режиме высокого уровня инжекции. № 6 стр. 41.

Неустроев С.А. Удаление фоторезиста озон-кислородной смесью. № 6 стр. 51.

Петров Б.К., Николаенков Ю.К. Переходные процессы при выключении высоковольтных БТИЗ в схеме полумоста. № 5 стр. 43.

Платонов В.В., Герасименко Н.Н., Вернер И.В., Троицкий В.Ю. Метод локального анизотропного плавления для определения приповерхностных дефектов в кремнии после термообработок. № 4 стр. 21.

Погалов А.И., Петрова В.З., Тимошенко С.П., Ферулев Д.А. Оптимизация параметров многослойных структур микросенсоров. № 3 стр. 41.

Рыгалин Б.Н. Процесс автолегирования из подложки с акцепторной примесью при эпитаксии кремния. № 5 стр. 40.

Тимошенко В.П., Тимошенко С.П., Миндеева А.А. Разработка конструкции микрогроскопа на основе КНИ-технологии. № 6 стр. 46.

Устюжанинов В.Н., Фролова Т.Н., Якунина М.В. Релаксационные процессы в $p-n$ -переходах при импульсном гамма-облучении. № 6 стр. 17.

Хайновский В.И., Уздовский В.В., Гордо Н.М. Многоканальные спектрально-фоточувствительные объемные приборы с зарядовой связью. № 3 стр. 45.

Шнитников А.С., Борисова Н.А. Моделирование многослойных диодных структур для управляющих устройств СВЧ-диапазона. № 1-2 стр. 63.

Схемотехника и проектирование

Бирюков В.Н., Шурховецкий А.Н. Идентификация параметров барьерной емкости. № 4 стр. 41.

Бубенников А.Н., Зыков А.В., Ракитин В.В. Численное моделирование и оптимизация низковольтных вертикальных совмещенных МОП-структур УБИС. № 3 стр. 59.

Бубенников А.Н., Зыков А.В., Ракитин В.В. Численное моделирование планарных совмещенных МОП-структур для низковольтных быстродействующих УБИС. № 1-2 стр. 79.

Волощенко П.Ю. Алгоритм анализа импедансных характеристик элемента колебательной системы многоструктурного лавинно-пролетного диода. № 6 стр. 61.

Григорьев М.А., Навроцкая Ю.Н., Шаров В.П. Проектирование генератора Ганна на основе экспериментальной зависимости адмитанса кристалла от амплитуды напряжения и частоты. № 1-2 стр. 104.

Казеннов Г.Г., Кремлев В.Я., Дьяконов В.М. Классификация методов физико-топологического моделирования элементов СБИС. № 4 стр. 33.

Казеннов Г.Г., Щемелинин В.М. Математическая модель эскиза конструкции сложных изделий электронной техники. № 1-2 стр. 112.

Ковалев А.В., Коноплев Б.Г. Метод мозаичного синтеза топологии заказных СБИС. № 4 стр. 52.

Куликов О.А., Макаров С.В., Перминов В.Н. Процедура сингулярного разложения матриц специального вида в системах схемотехнического моделирования СБИС. № 4 стр. 45.

Ланцов В.Н., Масленков А.В. Анализ параметрических устройств эффективным итерационным методом. № 1-2 стр. 97.

Новиков С.Г., Новоселов А.Ю., Бакланов С.Б., Гурин Н.Т. Схемотехническое моделирование и исследование мощных N -транзисторов. № 1-2 стр. 86.

Рындин Е.А. Сравнительный анализ методов структурного резервирования микросистем. № 5 стр. 75.

Сырцов И.А. Алгоритм сжатия топологии СБИС на основе силовой модели. № 6 стр. 69.

Сырцов И.А., Загидуллин М.Р. Векторная модель макротрассировки сигнальных цепей в иерархических системах проектирования топологии СБИС. № 3 стр. 73.

Турулин И.И. Метод проектирования цифровых рекурсивных фильтров с конечной импульсной характеристикой с заданными огибающей и заполнением. № 1-2 стр. 91.

Щемелинин В.М., Данилин А.А. Многоуровневая модель трассировки свичбокса. № 3 стр. 65.

Щемелинин В.М., Данилин А.А. Трассировка свичбокса методом расширения спецификаций. № 6 стр. 77.

Интегральные радиоэлектронные устройства

Чистюхин В.В., Кашаев Н.К. Плоские печатные микрополосковые антенны. № 5 стр. 81.

Методы и техника измерений

Антропов В.Ю., Иванов А.И., Сизов В.И. Многоканальный измеритель распределения температуры. № 4 стр. 86.

Арутюнов П.А., Толстихина А.Л., Демидов В.Н., Гайнутдинов Р.В., Щеглов Е.Г., Красивский И.Н. Феноменологические характеристики для анализа шероховатости и микрорельефа поверхности материалов в сканирующей зондовой микроскопии. № 6 стр. 89.

Байзер М.В., Закурдаев И.В., Фирсов Д.С. Особенности измерений эффективной работы выхода методом туннельной спектроскопии в атмосферных условиях. № 5 стр. 102.

Баранов А.М. Исследование в реальном масштабе времени параметров тонкопленочных покрытий нанометровой толщины методом рентгеновской рефлектометрии. № 3 стр. 89.

Баранов А.М. Метод рентгеновской рефлектометрии для оценки влияния неоднородности растущей пленки на значения измеряемых параметров. № 5 стр. 107.

Буданова Е.Е., Пахомова И.Ю., Суворинов А.В., Филипчук Т.С., Шахбазов С.Ю. Замедляющая электронная оптика для низковольтных электронно-зондовых приборов. № 4 стр. 71.

Волк Ч.П., Новиков Ю.А., Озерин Ю.В., Раков А.В. Особенности изображения микроструктур нитрида кремния на кремнии в РЭМ во вторичных медленных электронах. № 6 стр. 83.

Ждан А.Г., Чучева Г.В. Термомодуляционная идентификация квазистационарного уровня сигналов в условиях сверхмедленной релаксации. № 5 стр. 91.

Лучинин В.В., Панов М.Ф. Эллипсометрическая диагностика переходных слоев в системе карбид кремния - естественный или термический окислы. № 4 стр. 80.

Максимов К.С. Автокатализ в эпитаксиальных технологиях. № 6 стр. 103.

Осокин Н.Е. Определение параметров нелинейности ВАХ резистивных структур методом импульсного тестового воздействия. № 1-2 стр. 119.

Платонов В.В., Герасименко Н.Н., Дягилев В.В., Вернер И.В. Особенности анализа поверхностных дефектов на кремнии методом локального анизотропного плавления. № 6 стр. 95.

Райнова Ю.П., Бархоткин А.В. Диагностика и контроль быстрых термических процессов. № 4 стр. 59.

Тюрнев Н.В., Соколов Е.Б., Петров С.В., Яремчук А.Ф. Расчет чувствительности установки с коаксиальным излучателем электромагнитных волн для измерения электрофизических параметров эпитаксиальных структур. № 5 стр. 94.

Яремчук А.Ф., Тюрнев Н.В., Петров С.В., Соколов Е.Б. Расчет чувствительности СВЧ-установки с щелевым излучателем для измерения электрофизических параметров эпитаксиальных структур на низкоомной подложке. № 3 стр. 81.

Биомедицинская электроника

Корнеев Н.В., Монтрель М.М., Быков В.А. Влияние заряда поверхности полиэлектролитной пленки на связывание нуклеозидмонофосфата. № 1-2 стр. 123.

Проблемы высшего образования

Гулидов Д.Н., Межуев С.В., Шабанов В.К. "Стандартизация и сертификация" и "Управление качеством" - новые специальности МИЭТ. № 4 стр. 93.

Трояновский В.М. Концепция разработки виртуальной лаборатории для внутривузовского и дистанционного обучения. № 1-2 стр. 127.

Краткие сообщения

Коваль А.Ю., Корнилов А.Р., Гуреев А.В., Соколов А.Г. Алгоритмы оценки области прямой видимости и уровня сигнала в САПР для телекоммуникационных систем. № 1-2 стр. 136.

Юбилей

В.И.Стафееву - 70 лет. № 1-2 стр. 138.

Пролейко В.М. К 90-летию со дня рождения Шокина А.И. № 4 стр. 96.

Конференции

Информационное сообщение о международной научно-технической конференции "Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники ПЭМ-99". № 1-2 стр. 140.

Информационное сообщение о VI Всероссийской межвузовской научно-технической конференции студентов и аспирантов "Микроэлектроника и информатика-99". № 3 стр. 97.

Международная научно-техническая конференция "Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники". № 5 стр. 114.